

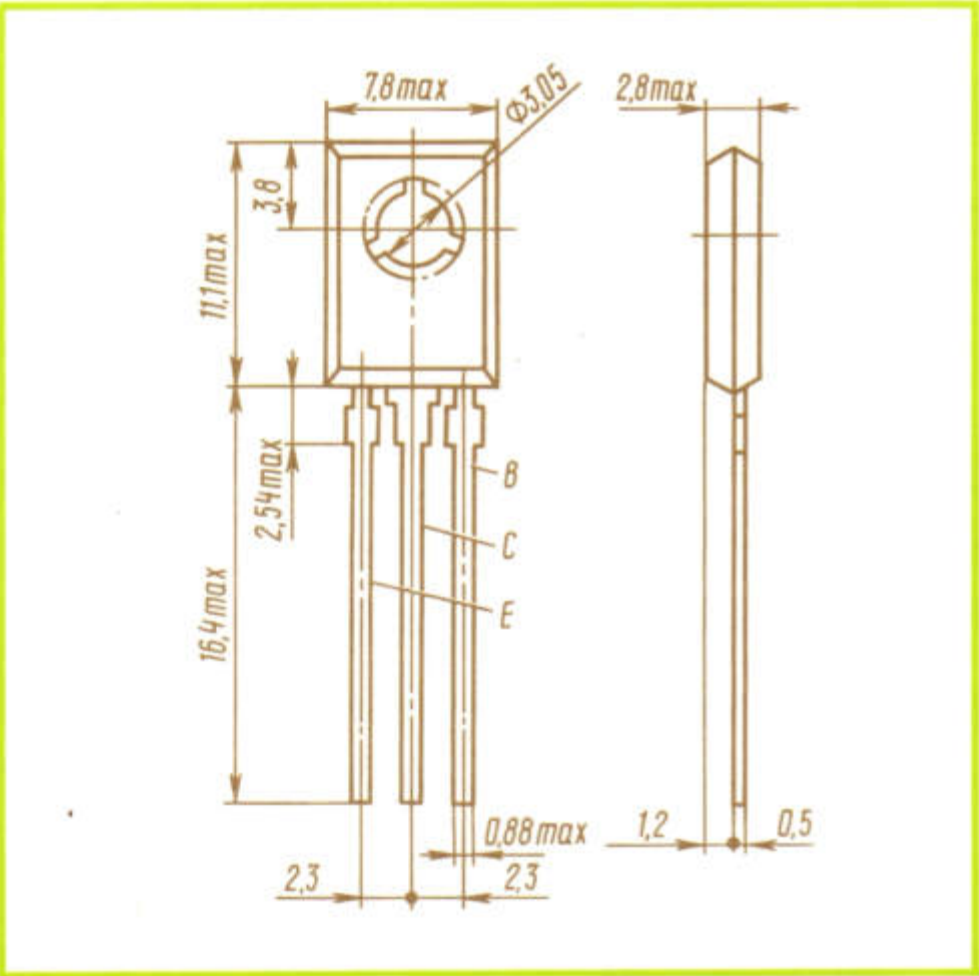
ТРАНЗИСТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
MEDIUM-POWER HIGH-FREQUENCY TRANSISTORS

KT646A

Транзисторы KT646A предназначены для работы в оперативных и постоянных запоминающих устройствах, управляющих вычислительных комплексах и другой радиотехнической аппаратуре широкого применения.

Si-n-p-n-EP

The KT646A transistors are designed for use in RAMs and ROMs, in control computer complexes and other radio equipments in a wide range of applications.



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{amb} = -45...+85^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

$I_{C\max}, A$	1
$I_{CM\max}, (t_p \leq 10 \mu s, Q \geq 5), A$	1,2
$U_{CB\max}, V$	60
$U_{CE\max}, (R_{BE} = 0), V$	60
$U_{CE\max}, (R_{BE} = 1 k\Omega), V$	60
$U_{EB\max}, V$	4
$P_{C\max}, (t_{amb} \leq 25^{\circ}C), W$	1
$P_{PM\max}, (t_p \leq 10 \mu s, Q \geq 5), W$	1,2
$t_j\max, ^{\circ}C$	150

*При $t_{amb} > 25^{\circ}C \Rightarrow P_{C\max} = \frac{150 - t_{amb}}{125}$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT646A	Режимы Conditions
1	2	3
$I_{CBO}, \mu A$	≤ 10	$U_{CB} = 60 V$
h_{21E}	40–200	$U_{CB} = 5 V$ $I_E = 200 mA$ $f = 50 Hz$
$ h_{21e} $	≥ 2	$U_{CB} = 10 V$ $I_C = 30 mA$ $f = 10^6 Hz$
$U_{CE\ sat}, V$	$\leq 0,8$	$I_C = 500 mA$ $I_B = 50 mA$

KT646A

1	2	3
C_c, pF	≤ 10	$U_{CB} = 10 \text{ V}$ $I_E = 0$ $f = 10^7 \text{ Hz}$

1	2	3
t_s, ns	≤ 70	$I_C = 150 \text{ mA}$ $I_B = 15 \text{ mA}$

